

⑨ 日本国特許庁 (JP) ⑩ 特許出願公開
⑪ 公開特許公報 (A) 昭59—218728

⑫ Int. Cl.³
H 01 L 21/265

識別記号 厅内整理番号
6851—5F

⑬ 公開 昭和59年(1984)12月10日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑭ 半導体基体への不純物導入方法

⑮ 特 願 昭58—93219

⑯ 出 願 昭58(1983) 5月26日

⑰ 発明者 佐藤則忠

横須賀市長坂2丁目2番1号株
式会社富士電機総合研究所内

⑱ 発明者 関康和

横須賀市長坂2丁目2番1号株

式会社富士電機総合研究所内
石渡統

横須賀市長坂2丁目2番1号株

式会社富士電機総合研究所内

株式会社富士電機総合研究所
横須賀市長坂2丁目2番1号

⑲ 発明者 富士電機製造株式会社
川崎市川崎区田辺新田1番1号

⑳ 代理人 弁理士 山口巖

明細書

1. 発明の名称 半導体基体への不純物導入方法

2. 特許請求の範囲

1) 真空容器内に収容した半導体基体を所定の温度に加熱し、前記容器内に不純物を含むふん団気中でグロー放電を発生させ、次いで不活性ふん団気中でグロー放電を発生させることを特徴とする半導体基体への不純物導入方法。

3. 発明の詳細を説明

【発明の属する技術分野】

本発明は半導体基体にドナーまたはアクセプターとしての不純物を導入して基体と不純物濃度が異なる所定の導電形の領域を形成する方法に関する。

【従来技術とその問題点】

この種の半導体領域を形成するためには、熱拡散、エピタキシャル成長、イオン注入などが知られている。これらの方は、いずれも半導体基体に800～1250°Cの熱処理を加える必要がある。このような高溫熱処理は半導体基体中に結晶欠陥が生じ、また金属元素が熱処理炉から半導体基

体中に拡散するため、キャリヤーのライフタイムを低下させてしまうほかに、10kPa～cm以上の高圧抵抗を有するシリコンの場合は、その結晶中に含まれる酸素がドナー化するため、抵抗が低下するなどの欠点があり、母材結晶本来の特性を維持することは困難である。

このようき欠点は、熱処理温度を低くすれば解決するが、従来技術を用いて、單に温度を低くするだけでは、形成される半導体領域の不純物濃度及び拡散係数のばらつきが大きくなり、再現性も悪くなる。例えば、熱拡散法ではドーパント不純物の半導体基体中での拡散係数が低下し、800°C以下の熱拡散は不可能に近い。

そのほかに、深さ0.2μm以下の後期半導体領域を母材の半導体表面に形成することは極めて困難である。例えば、イオン注入法でこの後期半導体領域を形成するためには、加速電圧30kV以下にするか、半導体基体表面に酸化膜を初めに形成し、その酸化膜を通してドーパント不純物のイオンを注入する必要がある。しかし加速電圧を低く

するにつれてイオン電流が得られにくく、表面不純物濃度を高くすることが困難であり、酸化膜を通して注入する場合は酸化膜厚のはらつきが極端半導体領域の表面濃度と拡散保さに影響を及ぼし、いずれも実用的ではない。とくに、酸化半導体領域に表面濃度 10^{20} 原子/ cm^2 以上の不純物注入層を得ることは不可能である。

このような欠点は、例えば、比抵抗 $10 \text{ k}\Omega \cdot \text{cm}$ 以上の高純度高比抵抗シリコンを用いて半導体放射線露出装置を製作する場合、高強熱処理が原因で、半導体基体のキャリーライフタイムが低下し、その結果 S/N 比が悪くなり、あるいは形成される表面ドーピング層が少くとも $5 \mu\text{m}$ 以上の深さを有するため、放射線に対して不感領域となるこの領域が厚くなるなどの問題がある。

一方、最近工業的に注目されている非晶質半導体に不純物を導入した領域を形成することについては、すでに種々の方法が開示されている。例えばははう素をドーピングするため最も一般的に行われる方法はモノシリラン (SiH_4) とジポラン (B_2H_6)

を同時に反応槽内に導入させ、グロー放電を発生させてはう素がドーピングされた非晶質シリコンを得るものである。しかしこの方法では、高い階層で形成できるものの、はう素を 10^{21} 原子/ cm^2 以上非晶質シリコン中に導入することは不可能に近く、その比抵抗も低くならない。また二つのガスを同時に導入させる際、ガス量比の割合が困難で再現性が悪いという欠点があつた。

【発明の目的】

本発明は、これに對して半導体基体を局部に加熱することなく、基体中に浅くて表面不純物濃度の高い所定の導電形の半導体領域を再現性よく形成できる不純物導入方法を提供することを目的とする。

【発明の要點】

本発明は真空容器内に収容した半導体基体を所定の温度に加熱し、その容器内に不純物を含むふん囲気中でグロー放電を発生させることにより半導体基体表面に不純物導入層を形成し、次いで不活性ガスふん囲気中でグロー放電を発生させ先に

導入した不純物を電気的に活性な不純物に変換することにより上記の目的を達成する。

【発明の実施例】

第 1 図は、本発明を実施するための反応槽の概略図で、真空容器 1、乾燥 2a、2b、半導体基体 3、真空排気系 4、ドーバント不純物を含むガスポンベ 5a と不活性ガスポンベ 5b、及びこれらのガスの圧力と流量を調整するための調整回路 6、グロー放電用 DC 電源 7a、半導体基体加熱用電源 7b、グロー放電時のガス圧力を調整するための真空バルブ 8、及び真空計 9 から構成されている。

まず、真空排気系 4 により、真空容器 1 内を排気し、約 1×10^{-7} Torr の真空にしたのち、真空バルブ 8 を取り、真空排気系 4 の排気速度を下げる同時に、真空容器 1 に不純物ガスを調整回路 6 を通して導入し、公知のやり方で電源 2a、2b 間に電圧を印加してグロー放電を発生せると同時に半導体基体 3 にその不純物を含む半導体領域が形成される。次に、アルゴンなどの不活性ガスふん囲気中でささらにグロー放電を

発生させると、先に導入した不純物は、グロー放電時間との経過と共に格子間位臵から置換型位置におきかわり、電気的に活性な不純物が増加する。

第 2 図および第 3 図はその実験例を示すドーバント不純物濃度分布のプロファイルである。つまり、Y 軸はドーバント不純物濃度、X 軸は半導体基体表面から深さ方向への距離である。この測定には、IMA (イオン・マイクロ・アナライザ) と抜がり抵抗法とを用いた。IMA とはよく較られたイオンビームを試料に照射して、その試料から二重的に放出される二次イオンを質量分析計に導き、質量を荷葉に分けて検出し、試料の元素分析を行いう方法で、半導体基体に拡散した電気的に活性な不純物ばかりでなく、電気的に不活性な不純物も全て検出する。一方、抜がり抵抗法は、半導体表面に 2 本の測定探針を立て、その間の電気抵抗を測定し比抵抗を求める方法で、粗略的に活性な不純物のみを検出する方法である。

第 2 図はシリコン半結晶基板上にはう素を導入した場合の一例で、この諸条件は下記の通りであ

る。

(II) 不純物導入条件

半導体基材：シリコン、n型、比抵抗1.0～
3.0Ω·cm、鏡面仕上げ

基材温度：300°C

ドーパント不純物ガス：水素で1000ppmICL
たジボラン希釈

グロー放電時の圧力：2.0Torr

放電パワー：DC 400～600V, 0.6mA/cm²

電極間距離：5.0mm

放電時間：60分

④ 電気的活性化条件

不活性ガス：アルゴン

グロー放電時の圧力：0.1Torr

放電パワー：DC 600V, 0.6mA/cm²

基材温度：100～300°C

放電時間：120～360J分

第2図の曲線1.0はIMAで求めた不純物濃度分布であり、このうち電気的に活性な不純物の濃度分布を抜き取り抵抗で求めたものが曲線1.1であ

る。ジボランの分解により生じ、シリコン単結晶中に侵入したほう素の大部分はシリコン単結晶の格子間位数に入り、格子の位置に入る配換型のほう素原子が少く、その結果電気伝導度に寄与する量が少いことを示している。曲線1.2, 1.3, 1.4は、このシリコンウエハを、さらにアルゴンガスふん囲気中で、それぞれ1.20分, 2.40分, 3.60分ごとに放電を行つたのち、並がり抵抗法で求めた濃度分布である。これより、グロー放電の時間を変えて任意の表面濃度を有する半導体領域が得られることがわかる。

第3図は、別の実施例を示すもので、第2図と相違する点は、ほう素の代りにりんを抵抗させた点で、n型の半導体領域が形成できる。その条件を次に示す。

(II) 不純物導入条件

半導体基材：シリコン、p型、比抵抗1.0～3.0

Ω·cm 鏡面仕上げ

反応温度：300°C

ドーパント不純物ガス：ヨウ素を水素で

1000ppmICL希釈したフオスファイン

グロー放電時の圧力：2.0Torr

放電パワー：DC 600V, 0.6mA/cm²

電極間距離：5.0mm

放電時間：60分

⑤ 電気的活性化条件：第2図について示した条件と同じ

第3図の曲線2.0はIMAで求めた導入りん濃度分布であり、曲線2.1は抜き取り抵抗で求めた電気的に活性なりんの濃度分布である。また曲線2.2, 2.3はさらにアルゴン中のグロー放電により電気的活性化を1.20分, 2.40分行つたあとでの抜き取り抵抗法で求めた濃度分布である。すなわち、第2図と同様な結果が得られ、放電時間と共に電気的に活性なりん濃度が増加する。

このようなアルゴンふん囲気中のグロー放電はスペッタリングと呼ばれ、イオン化したアルゴンイオンを、例えばシリコン表面に衝突させるとシリコン原子がはじき飛ばされ新しい原子層が誕

生するので、結晶表面の精制化に用いられるものである。しかし、本発明で用いたグロー放電条件は従来のスペッタリング法にくらべアルゴンガスの圧力が高く、加速電圧が低いため、シリコン表面に侵入したポロン原子はアルゴンイオンによりはじき飛ばされるよりも、むしろシリコン単結晶中にノックオンされ、しかも、シリコン表面部の濃度が局部的に高くなり、その結果、格子間位数に存在するドーパント原子が格子の位置、すなわち配換型になるため電気伝導度が増加するものと考えられる。

上記の実施例では、ほう素およびりんについて述べたが、アンチモン、ひ素、ガリウム、アルミニウムなど不純物を同様に導入した半導体領域について、アルゴン、ヘリウムなどの不活性ガスふん囲気中でグロー放電を行えば、もちろん電気的活性度は増加する。そのほかに、光絶出素子などに使用する非晶質シリコン被膜上に、ほう素やりんなどの不純物ガスふん囲気でグロー放電、不活性ガスふん囲気中グロー放電を行うと、より低比

抵抗の不純物層を有する pn 接合の極薄非晶質膜も容易に得られる。

〔発明の効果〕

この差別は、例えば 300°C 以下の低温度で、単結晶や非晶質半導体基体中にドーパント不純物を導入させる方法である。先ず不純物ガスふん囲気中でグロー放電を発生させて不純物を導入し、ついでアルゴンなどの不活性ガスふん囲気中でグロー放電を行うと、上記のように電気的に活性な表面不純物濃度は $10^{16} \sim 10^{22}$ 原子/cm² の任意の範囲で、しかも 1500A 以下の深さの不純物導入層が得られる。

すなわち、熱拡散法やイオン注入法では不可能な極薄で表面不純物濃度の高い半導体領域が得られ、放射線露出素子に適用した場合は、pn 接合層のような放射線に対する不感層の領域を薄くできるばかりでなく、低温処理工程のため結晶本来の特性を保持するので、SN 比を高め、エネルギー分辨能力を向上させることができる。

非晶質シリコンを用いた光検出素子では、不純

物ドーピング層を形成する際、従来のようにシリコンガスとドーパントガスとを最適混合比で反応槽内に送るための操作が不要になり、ドーパントガスのみを流してグロー放電及び不活性ガス中のグロー放電を発生させれば良いため、従来法では不可能に近いような低比抵抗不純物ドーピング層で、しかも極薄層が得られる。

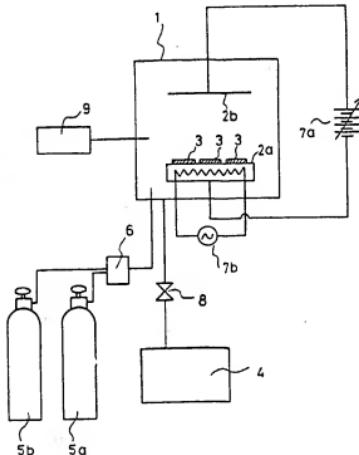
ブレーナ型素子や MOSIC 素子では、酸化膜の形成、接合蒸気の変動など、高微熱処理工程により生じる特性の変化が少くなるなどの効果が上記した簡単な装置でも容易に得られる。とくに熱拡散法やイオン注入法では不可能な極薄拡散層で高い表面濃度の半導体領域が形成できる。

4. 図面の簡単な説明

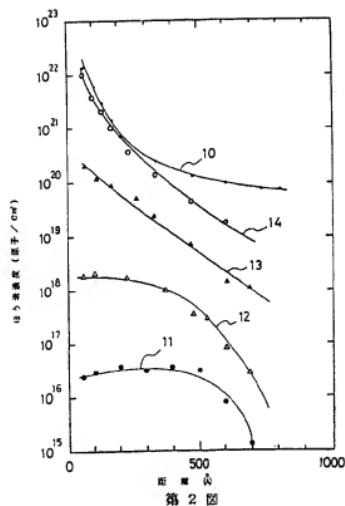
第 1 図は本発明を実施するための反応装置の一例の概略構成図、第 2 図はドーパント不純物としてはウランを拡散した場合の濃度分布を示すプロファイル線図、第 3 図はドーパント不純物としてウランを拡散した場合の濃度分布を示すプロファイル線図である。

1 …… 真空容器、 2a, 2b …… 電極、 3 …… 半導体基体、 4 …… 真空排気系、 5a …… ドーパントガスボンベ、 5b …… 不活性ガスボンベ、 6 …… グロー放電用電源、 7a …… 基体加熱用電源。

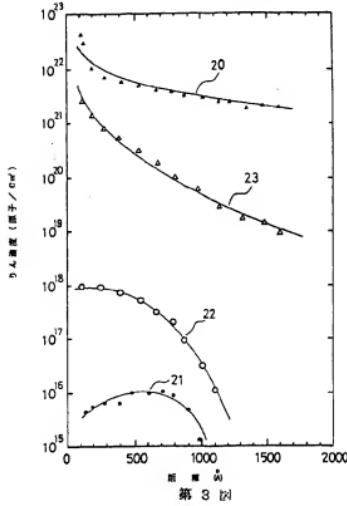
（出力印）山口



第 1 図



第 2 図



第 3 図